EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

63084051

PUBLICATION DATE

14-04-88

APPLICATION DATE

26-09-86

APPLICATION NUMBER

61229050

APPLICANT: MATSUSHITA ELECTRONICS CORP;

INVENTOR: NOZAKI HIDEYO;

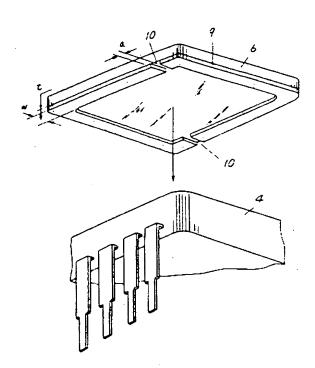
INT.CL.

H01L 23/02 H01L 27/14

TITLE

MANUFACTURE OF

SEMICONDUCTOR DEVICE



ABSTRACT: PURPOSE: To improve yield on the manufacture of a semiconductor device by forming a slit for gas vent at a corner section in a thermo-setting resin layer on the inner surface of a cover plate and making the slit to disappear at a sealing treating stage when the resin lay er is heated and melted.

> CONSTITUTION: A cover plate 6 consisting of a square-shaped glass plate has a square frame-shaped thermo-setting resin layer 9 applied and shaped through printing on an inner surface thereof. The resin layer 9 has slits 10 for gas vent at corner sections thereof. The cover plate 6 is placed on a square-shaped opening section in a case 4 made of ceramics. The resin layer 9 is heated and melted in a nitrogen atmosphere, applying load to the cover plate 6, and sealing treatment is executed. Consequently, the slit 10 conducts expected gas vent action, and is buried completely with a molten resin and is made to disappear. Accordingly, yield on the manufacture of a semiconductor device is improved.

COPYRIGHT: (C)1988,JPO&Japio

THIS PAGE BLANK (USPTO)

⑬ 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭63 - 84051

⑤Int Cl.⁴

證別記号

庁内整理番号

磁公開 昭和63年(1988)4月14日

H 01 L 23/02

27/14

Z-6835-5F F-6835-5F

D - 7525 - 5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

会発明の名称

半導体装置の製造方法

頤 昭61-229050 ②特

頤 昭61(1986)9月26日 砂出

母発 明 者 明 者 関 蝣

侒 英 世 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電子工業株式会社内 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電子工業株式会社内

⑫発 松下電子工業株式会社 ①出 願

大阪府門真市大字門真1006番地

弁理士 中尾 敏男 砂代 理

外1名

1、発明の名称

半導体装置の製造方法

2、特許請求の範囲

固体機像素子等の半導体素子を収容してなるセ ラミック製ケースの方形状開口部に気密に封着さ れる蓋板の内面に、前記開口部に沿った四角枠状 の熱硬化性樹脂層を塗布形成するにさいし、この 樹脂層のコーナ部にガス抜き用のスリットを有せ しめ、前記蓋板と前記開口部とによって挟み込ま れた前記樹脂層を加熱溶融する封着処理段階にお いて前記スリットを消失せしめることを特徴とす る半導体装置の製造方法。

3、発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は、固体操像素子等の半導体素子を収容 してなるセラミック製ケースの方形状開口部に、 方形状の蓋板を気密に封着してなるパッケージ型 半導体装置の製造方法に関する。

従来の技術

従来、第3因に示すように、方形状の固体操像 素子1、色分離用カラーフィルタ2およびフレヤ 防止板3をセラミックまたは合成樹脂製のケース 4 内に固着したのち、ケース4 の方形状開口部 5 に透明ガラス平板からなる蓋板6を窒素ガス雰囲 気中で気密に封着することが行なわれている。

この場合、封着剤としての熱硬化性樹脂層?を **置板6の内面にあらかじめ四角枠状に途布形成し** でおき、開口部5に樹脂層7を重ね合わせた状態 で蓋板6に荷重を与え、樹脂層7を加熱容融す

発明が解決しようとする問題点

ところが、前記加熱溶融の段階で熱膨脹したケ ース4内のガスが、溶融した四角枠状の樹脂層? を内側から不規則的に押圧する結果、この樹脂層 7 のとくに内局面が不規則的に変形し、気密針着 効果を損なうことがあった。

そこで、第4図に示すように、査板6の内面に あらかじめ塗布形成される四角枠状樹脂層7の少 なくとも2辺の各中程にガス抜き用のスリット8

持開昭63-84051(2)

を設けておく提案がなされたのであるが、このスリット 8 を封着処理中に完全に消失させ得ずに残留させてしまうことがあった。このようなことがあると、ケース 4 内に窒素ガスをとどめることができなくなるのみならず、熱硬化性樹脂 7 は再加熱しても溶験しないので、高値な固体操像素子 1 およびカラーフィルタ 2 等を無駄にしてしまうことになる。

本発明者らの解析によると、前記スリットが消失せずに残留するのは、前記ケースがセラミック製の場合に多く、これはケース開口部針着面の平滑度に関係していることが判明した。すなわち、前記封着面に凹凸が存在すると、同面と蓋板との間隔が場所によって不同となり、。
な融した
数節
が
なりットの付近で十分に展延せずに、スリットを残留させてしまうことになる。

問題点を解決するための手段

本発明によると、固体操像素子等の半導体素子 を収容してなるセラミック製ケースの方形状開口 部に気密に封着される蓋板の内面に、前記開口部

第1図に示すように、方形状のガラス平板からなる蓋板6は、その内面にプリントにより塗布形成された四角枠状の熱硬化性樹脂層9を有し、エポキシ樹脂からなるこの樹脂層9は、そのコーナ部にガス抜き用のスリット10を有している。なお、樹脂層9の各幅wが約1.6 mm、厚さ t が約0.0 7 mm である場合のスリット10の幅 a は約0.3 mm に設定できる。

このように構成された蓋板構体を図中に矢印で示す方向に下降させ、固体機像素子等を収容してなるセラミック製ケース4の方形状開口部に敬せる。そして、蓋板6に荷重を与えつつ樹脂層9を窒素雰囲気中で加熱溶験し、針着処理を施すのは従来どおりである。

このようにすると、前記閉口部の封着面にたとえ凹凸が存在していても、同封着面の四隅における高さおよび平滑度は比較的均等であるので、この四隅上に位置するスリット10は所期のガス抜き作用を果たしたのち、溶融した樹脂によって完全に埋められ消失する。

に沿った四角棒状の熱硬化性樹脂層を全布形成するにさいし、この樹脂層のとくにコーナ部にガス 抜き用のスリットを有せしめる。そして、前記蓋板と前記開口部とによって挟み込まれた所記樹脂層を加熱溶験する封着処理段階において前記スリットを消失せしめる。

作用

実施例

つぎに、本発明を図面に示した実施例とともっ に詳しく説明する。

スリット10は第2図に示す位置に設けてもよく、また、四隅のうちのどこに設けてもよく、その数は2つ以上であってもよい。

以上は固体操像素子を半導体素子とする半導体接近の製造についてのべたが、本発明は、その他のパッケージ型半導体装置の製造にも適用することができる。

発明の効果

本発明は前述のように構成されるので、蓋板の 内面にあらかじめ四角枠状の樹脂履を塗布形成する段階で使用する印刷用スクリーン原版にわずか な改造を施すだけで、パッケージ型半導体装置の 製造歩留を著しく向上させることができる効果大 なるものである。

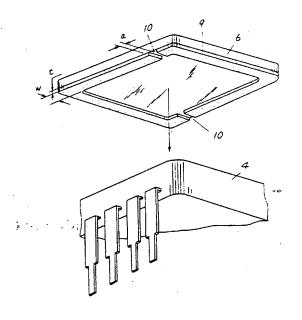
4、図面の簡単な説明

第1図は本発明の製造方法によって製造される 半導体装置の要部の分解料視図、第2図は本発明 の他の実施例における透板構体の平面図、第3図 はパッケージ型半導体装置の一部破断料視図、第 4図は従来の蓋板構体の平面図である。

特開昭63-84051(3)

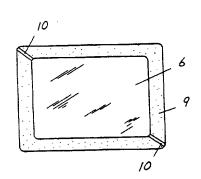
1・・・・・・ 固体機像素子、4・・・・・ケース、6・・・・・・ 蓋板、9・・・・・ 樹脂層、10・・・・スリッ

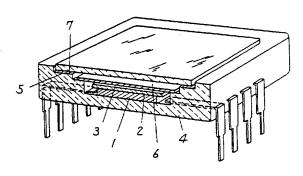
代理人の氏名 井理士 中 尾 敏 男 ほかし名



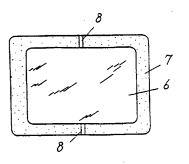
第二3 以

第 2 図





第 4 図



THIS PAGE BLANK (USPTO)